



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 766 163 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
01.04.1998 Patentblatt 1998/14(51) Int. Cl.⁶: G05F 3/20, G05F 3/22(43) Veröffentlichungstag A2:
02.04.1997 Patentblatt 1997/14

(21) Anmeldenummer: 96114180.1

(22) Anmeldetag: 04.09.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(30) Priorität: 26.09.1995 DE 19535807

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

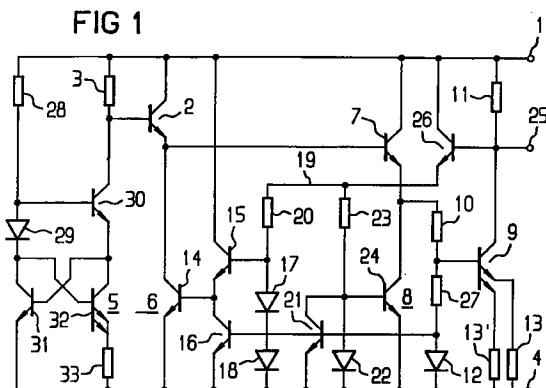
(72) Erfinder:

- Wilhelm, Wilhelm, Dr.
81477 München (DE)
- Hözl, Josef
86825 Bad Wörishofen (DE)

(54) Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Biaspotentials

(57) Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Biaspotentials mit einem kollektorseitig an ein Versorgungspotential (1) angeschlossenen ersten Transistor (2), einem zwischen Basis und Kollektor des Transistors (2) geschalteten ersten Widerstand (3), einer zwischen die Basis des ersten Transistors (2) und ein Bezugspotential (4) geschalteten ersten Stromquelle (5), einer zwischen den Emitter des ersten Transistors (2) und das Bezugspotential (4) geschalteten zweiten Stromquelle (6), einem kollektorseitig an das Versorgungspotential (1) und basisseitig an den Emitter des ersten Transistors (2) angeschlossenen zweiten Transistor (7), einer zwischen den Emitter des zweiten Transistors (7) und das Bezugspotential (4) geschalteten dritten Stromquelle (8), einem kollektorseitig das Biaspotential führenden dritten Transistor (9), einem zwischen den Emitter des zweiten Transistors (7) und die Basis des dritten Transistors (9) geschalteten zweiten Widerstand (10), einem zwischen den Kollektor des dritten Transistors (9) und das Versorgungspotential (1) geschalteten dritten Widerstand (11), einer zwischen die Basis des dritten Transistors (9) und das Bezugspotential (4) geschalteten ersten Diode (12) in Durchlaßrichtung und einem zwischen den Emitter des dritten Transistors (9) und das Bezugspotential geschalteten vierten Widerstand (13), wobei der vierte Widerstand (13) den halben Widerstandswert des zweiten oder dritten Widerstands (10, 11), die untereinander gleich groß sind, aufweist und zweite und dritte Stromquelle einen vom Kollektorstrom des dritten Transistors (9) abhängigen Strom liefern.

FIG 1





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 524 154 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) * das ganze Dokument *	1-7	G05F3/20 G05F3/22
A	EP 0 375 998 A (MOTOROLA INC) * das ganze Dokument *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6)
			G05F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		5. Februar 1998	Schobert, D
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		E : älteres Patendokument, das jedoch erst am oder	
A : technologischer Hintergrund		nach dem Anmeldeatum veröffentlicht worden ist	
O : nichtschriftliche Offenbarung		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
P : Zwischenliteratur		L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	